




	<h2>SI3493BDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3493BDV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3493BDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 71523 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3493BDV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	71523 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 8A (Tc) 2.08W (Ta), 2.97W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2.08W (Ta), 2.97W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27.5 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1805pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3493BDV-T1-GE3CT




SI3493BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3493BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3493BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3493BDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3493BDV-T1-E3-S</b> VISHAY SI3493BDV-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI3493DV-T1</b> VISHAY SI3493DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3493DDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 20V 8A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3493BDV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3493DV</b> VSHAY SI3493DV VSHAY</p>	 <p><b>SI3493DDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3493BDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3484-A01-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) POWER MANAGEMENT IC</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3475DV-T1-E3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3476DV-T1-E3	 SI3476DV-T1-GE3
 SI3476DV-T1-GE3	 SI3477DV-T1-E3	 SI3477DV-T1-GE3	 SI3477DV-T1-GE3	 SI3481DV-T1-E3
 SI3481DV-T1-E3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-E3	 SI3483CDV-T1-E3
 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483DV-T1-E3	 SI3483DV-T1-E3	 SI3483DV-T1-GE3
 SI3483DV-T1-GE3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3-S	 SI3493BDV-T1-GE3
 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DV	 SI3493DV-T1	 SI3493DV-T1-E3
 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3495DV
 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-E3
 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3500-A-GM	 SI3529DV-T1-GE3
 SI3529DV-T1-GE3	 SI3552DV	 SI3552DV-T1	 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-E3

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited